

# SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5961

SJ 20014~20016—92

---

**半导体分立器件  
GP、GT 和 GCT 级  
3CG110、3DG130、3DG182 型  
硅小功率晶体管详细规范**

**Semiconductor discrete device  
Detail specification for silicon low—power  
transistor for types 3CG110、3DG130、3DG 182  
GP、GT and types GCT classes**

1992-02-01 发布

1992-05-01 实施

---

中国电子工业总公司 批准

# 目 次

1	SJ 20014—92	3CG110 型 PNP 硅小功率晶体管详细规范 .....	(1)
2	SJ 20015—92	3DG130 型 NPN 硅高频小功率晶体管详细规范 .....	(11)
3	SJ 20016—92	3DG182 型 NPN 硅小功率高反压晶体管详细规范 .....	(21)

# 中华人民共和国电子行业军用标准

## 半导体分立器件

### GP、GT 和 GCT 级

#### 3DG182 型 NPN 硅小功率高反压晶体管

#### 详细规范

Semiconductor discrete device

Detail specification for NPN silicon low-power

high-reverse-voltage transistor for type 3DG182

GP、GT and GCT classes

SJ 20016—92

---

## 1 范围

### 1.1 主题内容

本规范规定了 3DG 182 型 NPN 硅小功率高反压晶体管(以下简称器件)的详细要求。该种器件均按 GJB 33—85《半导体分立器件总规范》的规定,提供产品保证的三个等级(GP、GT 和 GCT 级)。